

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



TYSiC

Guangdong Tianyu Semiconductor Co., Ltd.

廣東天域半導體股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2658)

**有關訂立
戰略合作協議的
自願公告**

本公告乃由廣東天域半導體股份有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司，統稱「**本集團**」)自願作出，旨在向本公司股東(「**股東**」)及本公司潛在投資者提供本集團最新業務發展情況。

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然公佈，於2026年1月16日(交易時段後)，本公司及青禾晶元半導體科技(集團)有限責任公司(「**青禾晶元**」)訂立戰略合作協議(「**協議**」)，據此，協議訂約方(各自為「**訂約一方**」，統稱「**訂約方**」)同意建立戰略合作，憑藉本公司在碳化硅材料領域的優勢及青禾晶元在鍵合設備定製與優化方面的能力，共同開展鍵合材料(包括鍵合碳化硅(SiC)、絕緣體上硅(SOI)、絕緣體上壓電基板(POI)及超大尺寸(12英寸及以上)SiC複合散熱基板)的工藝開發及技術迭代。

協議

協議的主要條款概述如下：

訂約方

- (i) 本公司；及
- (ii) 青禾晶元。

合作內容

1. **工藝開發：**本公司應就鍵合SiC、SOI、POI、12英吋SiC複合散熱基板及中介層等鍵合材料開展工藝開發及量產導入。
2. **設備與技術支持：**青禾晶元應向本公司提供離子注入、晶圓級鍵合、精密拋光、晶體修復及剝離等方面的設備及相關技術支持，主要包括：
 - 為單晶 — 多晶SiC鍵合襯底(8英吋)提供設備定製、優化及工藝調試；
 - 為單晶 — 單晶SiC鍵合襯底(8英吋)、SOI(8英吋及12英吋)及Si on SiC(12英吋)鍵合襯底提供整線設備選型、設備定製、工藝優化及量產支持；及
 - 提供適用於金剛石、氧化鎵(Ga_2O_3)、氮化鎵(GaN)、銦酸鋰、鉍酸鋰等材料的鍵合設備。
3. **設備改進及技術支持：**本公司應從工藝開發、批量製造的角度給予設備改進及升級迭代的指導。青禾晶元應配合本公司量產需求，加大研發投入，提升設備能力。同時，青禾晶元在本公司使用過程中遇到的技術問題，應積極配合應對。
4. **知識產權：**在技術開發過程中，訂約一方各自獨立研發的知識產權歸各自獨立所有。

5. **優先合作：**於合作期間，在同等條件下，本公司應優先與青禾晶元開展整線項目合作，並優先採購青禾晶元的相關設備。然而，若青禾晶元提供的設備無法滿足本公司的技術指標、量產良率要求或貨期需求，本公司有權向第三方採購，不視為違約。

期限

合作期限自2026年1月16日起至2029年1月15日止。

有關青禾晶元的資料

青禾晶元為一家於中華人民共和國成立的公司，專注於半導體鍵合集成技術。其核心業務涵蓋高端鍵合設備研發製造與精密鍵合工藝代工服務，技術應用於先進封裝、半導體器件製造、晶圓級異質材料集成及MEMS傳感器等前沿領域。

根據公開可得資料，青禾晶元由母鳳文直接持有22.25%股權，而青禾晶元餘下77.75%股權由43名股東持有，每位股東持股比例均低於10%。

經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，青禾晶元及其最終實益擁有人為獨立第三方，與本公司及其關連人士(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則)並無關連。

訂立協議的理由及裨益

本公司主要從事SiC外延片的生產及銷售。其產品組合包括4英吋、6英吋及8英吋SiC外延片。本公司的產品主要用於電動車、光伏及軌道交通等行業。本公司亦提供增值型的SiC外延片相關服務，包括SiC外延代工服務、外延片清洗服務以及襯底與外延片檢測服務。

董事會認為，訂約方將利用彼等各自的競爭優勢，建立互利互惠的合作夥伴關係。通過結合本公司在SiC外延片領域的行業實力與青禾晶元在鍵合集成技術及設備方面的專業知識，合作旨在促進先進鍵合材料解決方案的開發並優化生產工藝。預期此合作將提升本集團在大尺寸複合基板方面的技術能力，確保設備穩定性，並進一步鞏固本集團的市場地位。

董事會認為，與青禾晶元的合作將有利於本集團未來發展，並符合本公司及其股東的整體利益。

承董事會命
廣東天域半導體股份有限公司
主席兼執行董事
李錫光

香港，2026年1月16日

截至本公告日期，董事會包括執行董事李錫光先生，非執行董事歐陽忠先生及姜達才先生，獨立非執行董事賀正生先生、李旻女士及錢榮澤先生。